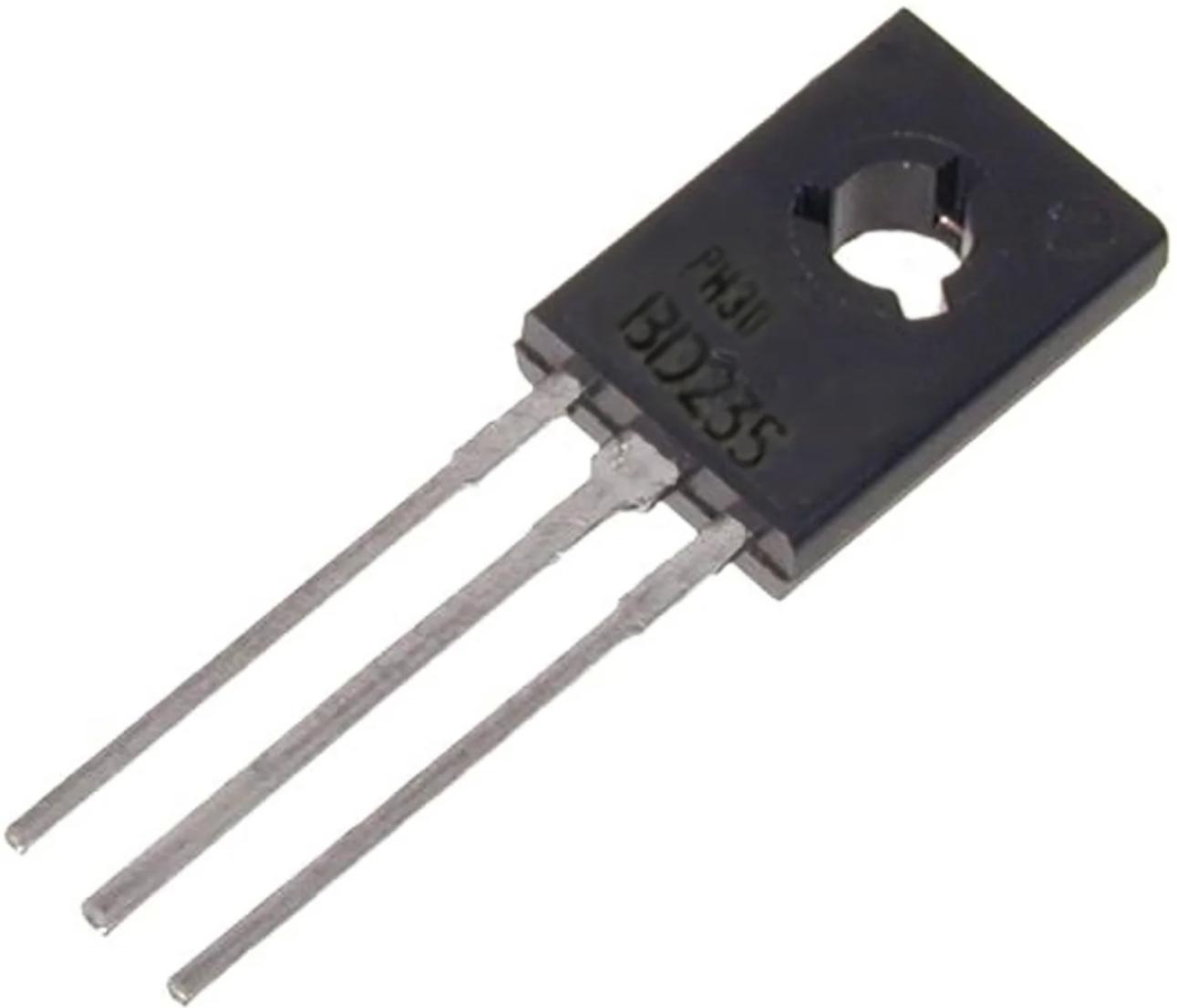




BD235: Transistor NPN Epitaxial Silicon 60V 2A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR NPN EPITAXIAL SILICON **Referencia:** BD235

- Polaridad de transistor: NPN
- Disipación total del dispositivo (P_c): 25 W
- Tensión colector-base (V_{cb}): 60 V
- Tensión colector-emisor (V_{ce}): 60 V
- Tensión emisor-base (V_{eb}): 5 V
- Corriente del colector DC máxima (I_c): 2 A
- Temperatura operativa máxima (T_j): 150 °C

Marca: ASI **Empaque:** TO-126 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BD235 por Fairchild](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR NPN EPITAXIAL SILICON. Marca: ASI. Referencia: BD235 El **BD235** es un tipo de **transistor de potencia NPN** diseñado para aplicaciones de **media potencia** tanto **lineales** como de **conmutación**. Su estructura interna se basa en una tecnología planar con un diseño de "isla de base", lo que le confiere un alto rendimiento y una baja tensión de saturación.

Precio: \$2.100 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-144

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000144](#), [9-5-144](#), [ASI](#), [BD235](#), [NPN](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN EPITAXIAL SILICON](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)